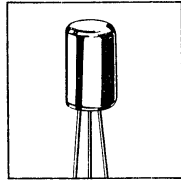


# 2SB186

ゲルマニウム・PNP・合金接合型  
AF小信号増幅用



☆ AF 小信号一般増幅用で AF アンプ・ドライブ用に最適です。

★ Germanium PNP alloy junction transistor.

★ For low power output driver.

## 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	2SB186	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-25	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-12	V
コレクタ電流	$I_C$	-150	mA
コレクタ損失	$P_C$	200	mW
接合部温度	$T_j$	85	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+85	$^\circ\text{C}$

## 電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	min.	typ.	max.	単位
コレクタ遮断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=-20\text{V}, I_E=0$			-15	$\mu\text{A}$
エミッタ遮断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=-6\text{V}, I_C=0$			-12	$\mu\text{A}$
小信号電流増幅率	$h_{fe}$	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}, f=1\text{kHz}$		120		
遮断周波数	$f_{\alpha b}$	$V_{CB}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}$		1		MHz
雑音指数	NF	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}, f=1\text{kHz}$ $R_g=500\Omega$ , 帯域幅=100Hz		8		dB
電力利得	PG ※	$V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-1\text{mA}, f=1\text{kHz}$ $R_g=2\text{k}\Omega, R_L=5\text{k}\Omega$	36		42	dB

※ 2SB186 は PG の値により 2 分類しています。

36	B	40	38	A	42
----	---	----	----	---	----

- これより電力利得の小さいものは 2SB185 ◯ P 145  
大きいものは 2SB187 ◯ P 153  
P<sub>C</sub> の大きいものは 2SB22 ◯ P 137
- オーディオ・アンプ・ドライブ一般 ◯ P 620,  
P 622, P 627

